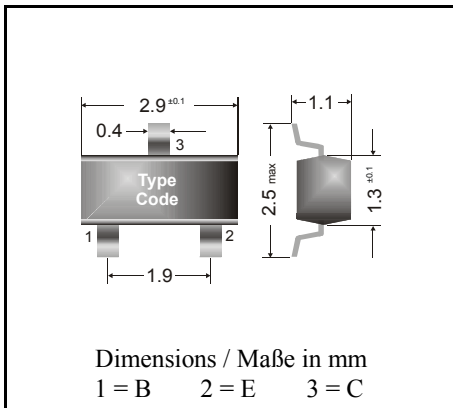


PNP

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

PNP



Power dissipation – Verlustleistung	250 mW
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

			BSS 63
Collector-Emitter-voltage	B open	$-V_{CE0}$	100 V
Collector-Base-voltage	E open	$-V_{CB0}$	110 V
Emitter-Base-voltage	C open	$-V_{EB0}$	6 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	250 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		$-I_C$	100 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	100 mA
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		$-I_{BM}$	100 mA
Junction temp. – Sperrschichttemperatur		T_j	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150°C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

		Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
$I_E = 0, -V_{CB} = 90\text{ V}$	$-I_{CB0}$	–	–	100 nA
$I_E = 0, -V_{CB} = 90\text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	$-I_{CB0}$	–	–	50 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom				
$I_C = 0, -V_{EB} = 6\text{ V}$	$-I_{EB0}$	–	–	100 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. ¹⁾				
$-I_C = 25\text{ mA}, -I_B = 2.5\text{ mA}$	$-V_{CEsat}$	–	–	250 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾				
$-I_C = 25\text{ mA}, -I_B = 2.5\text{ mA}$	$-V_{BEsat}$	–	–	900 mV

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾			
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$ h_{FE}	30	–	–
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 25\text{ mA}$ h_{FE}	30	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz			
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 25\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$ f_T	50 MHz	85 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität			
- $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$ C_{CB0}	–	3 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}		420 K/W ²⁾
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren	BSS 64		
Marking - Stempelung	BSS 63 = BM		

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß